



性能特点

- RF 频率范围: 0.5GHz~2.0GHz
- LO 频率范围: 0.5GHz~2.0GHz
- IF 频率范围: DC~0.5GHz
- 功耗: 105mA@+5V
- 本振功率: -5~0dBm
- 芯片尺寸: 4.00mm×2.00mm×0.08mm

产品简介

NC17126C-102 和 NC17126C-102M 是两款集成本振驱动混频器芯片, NC17126C-102M 为镜像版。采用 GaAs PHEMT 工艺制造, 集成以下功能电路:

- 混频器
- 本振驱动放大器

电参数: (TA=+25°C, IF=100MHz, LO=+13dBm)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	0.5 ~ 2.0			GHz
本振频率	0.5 ~ 2.0			GHz
中频频率	DC ~ 0.5			GHz
变频损耗	7	9	12	dB
LO-RF 隔离度	26	30		dB
LO-IF 隔离度	21	22		dB
RF-IF 隔离度	12	20		dB
射频输入 1dB 压缩点		+10		dBm

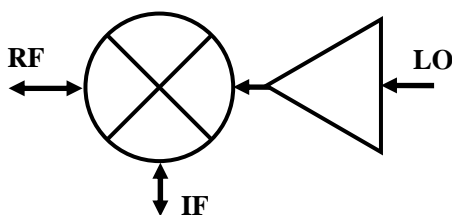
注: 除特殊标注, 以上参数均为下变频模式测得, 中频频率 100MHz, 本振功率 0dBm。

注: 对于兴趣频点的交调指标可以与我公司联系。

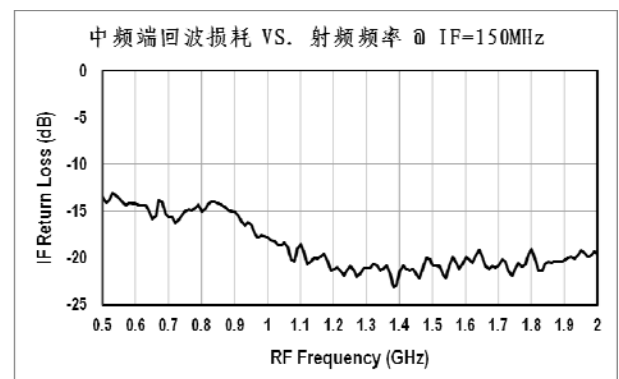
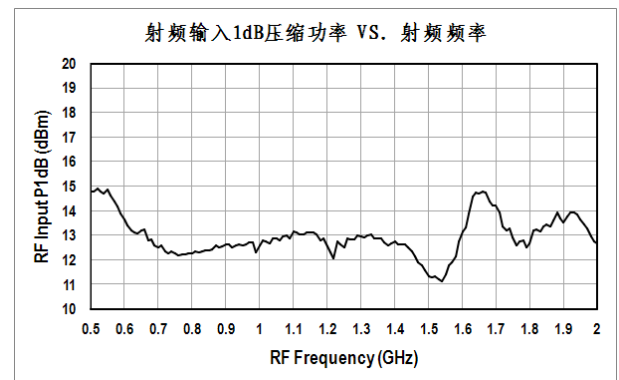
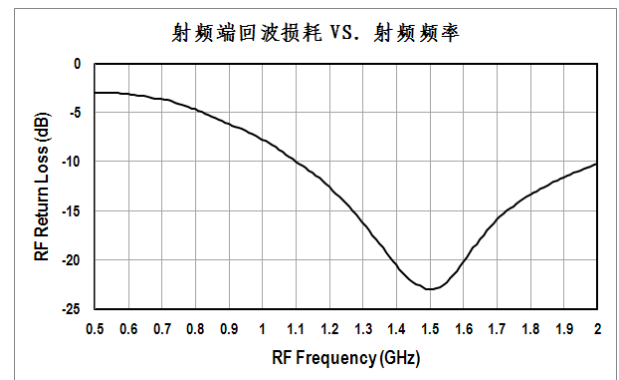
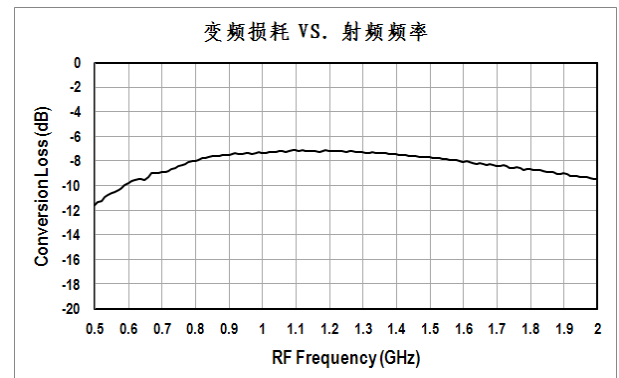
使用限制参数

最大输入正电源电压	+8V
最高输入功率	+15dBm
储存温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

原理框图



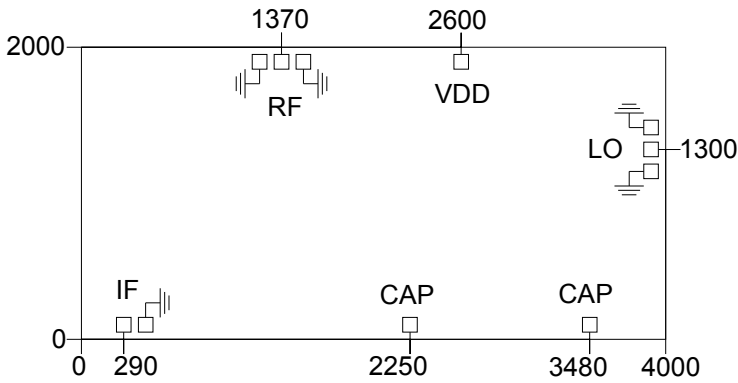
典型曲线



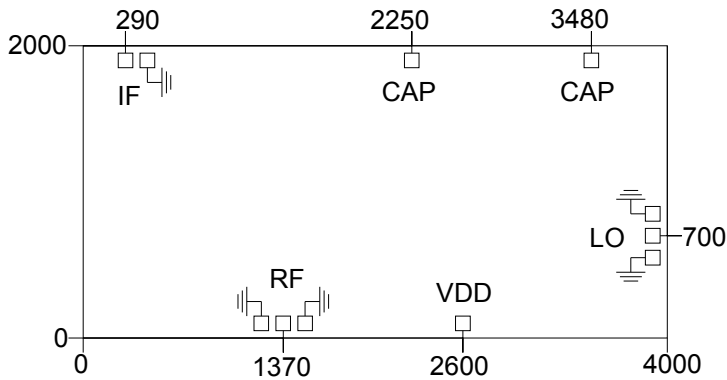


外形尺寸

NC17126C-102 外形尺寸图



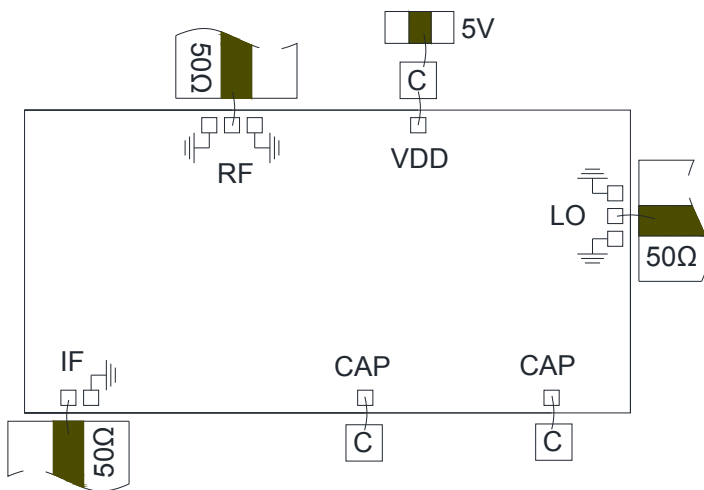
NC17126C-102M 外形尺寸图



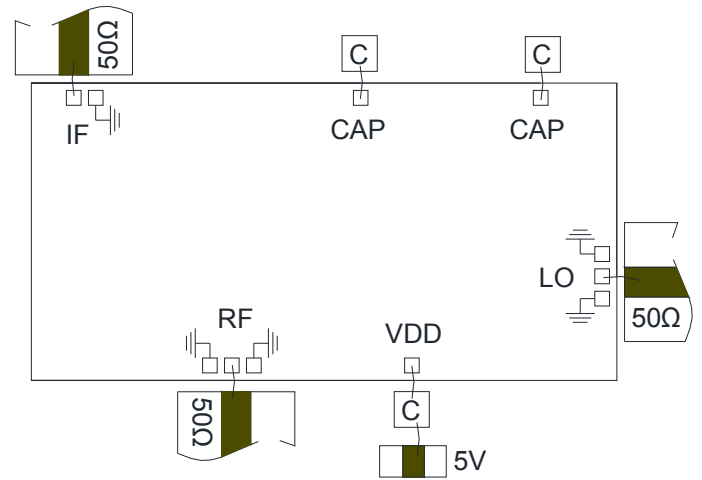
注：所有尺寸单位为微米（ μm ），压点尺寸 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ ；
外形尺寸公差 $\pm 50 \mu\text{m}$ 。

建议装配图

NC17126C-102



NC17126C-102M



注：C 为 100pF 芯片电容。

注意事项：

- 1) 在净化环境装配使用。
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心。
- 3) 用直径 $25 \mu\text{m}$ 金丝键合线键合线长度 $350 \mu\text{m}$ 左右最佳。
- 4) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度不要超过 300°C ，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒。
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
- 6) 干燥、氮气环境储存。
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。
- 8) 有问题请与供货商联系。